江苏芯丰集成电路封装压焊						图-	号:314	BD01	3	版本	A. 0	
贴片方向(芯片与片环	方向示意图)	框架			> ·							
			个孔为椭圆									
	「プロノリイ田区		 备注及特殊要求 (Remark&Special Instruction)									
			框架到芯片最高点的线弧高度<550um									
0.72												
-0.73												
VDD												
8.0		<u> </u>	9									
GND 16 9												
VDD 1							 	7 8				
VPP 1 8												
请仔细核对焊线位置,以及材料选择。 如无										 无误		
						请签字回传,谢谢! 客户回签:						
顶针 单顶针 多顶针	点胶 点胶	方式画胶	如选择UV膜 请确认 产品是否可以照	UV膜		:		<u> </u>				
• /	•	/	射紫外线, 如不能请讲明	蓝膜	低风险							
产品型号 (Product Type)	HS8000P		线 材 直 (Wire Diame	ter)	银合金线(0.8mil	芯片减薄厚		300	±10u	ım	
芯片名称 HS5122 (Die Name)		压焊点尺寸 (Pad Opening)		50. 35X50.	35um	装片胶 Epoxy	首选	NC9112	(绝缘	(胶)		
芯片尺寸 (Die Size) 対装形式		最小压焊间距 (Min Pitch)		60um		(二选一)	备选	/				
封装形式 SOP16L (9.9×3.9×1.4 (Package Type) e=1.27) 引线框 SOP16L (12R) (80×80)			先焊线 (Wire Bond Start)		PIN16		塑封料 Molding Compound	首选	EMC-GF	2710F	GN	
(Lead Frame) —H L/F电镀方式			焊线总数 (Quantity of Wire) 是长线长/总线长		17		(二选一)	备选	EMG-60	0-2-S	SP1	
(L/F Plating Type) 雾 锡			最长线长/总线长 (Length of Wire)		1. 49/21. 6	49/21.691mm		CUP/BOAC		s [NO NO	
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode) 8寸/刀片开槽+刀片切割			顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)		1.0um(3层)		RF 芯片		☐ YE	is I	NO	
吸 嘴 (suction nozzle)	11/1 010			切割道(Cutting Way)		60um		LOW-K芯片			NO	
拟制 Prepared by	顾馨 2024.04.	. 18	审核 Checked by				批准 Approved by					